

クローンの法則

1点 P (位置ベクトル) に置かれた電荷 e をもつ点電荷は

$$E(x) = \frac{e(x-P)}{4\pi\epsilon_0 \|x-P\|^3}$$

空間の点 P^1, \dots, P^N にそれぞれ電荷 e_1, \dots, e_N をもつ点電荷があるとする。このとき、電場は、

$$E(x) = \sum_{i=1}^N \frac{e_i(x-P^i)}{4\pi\epsilon_0 \|x-P^i\|^3}$$

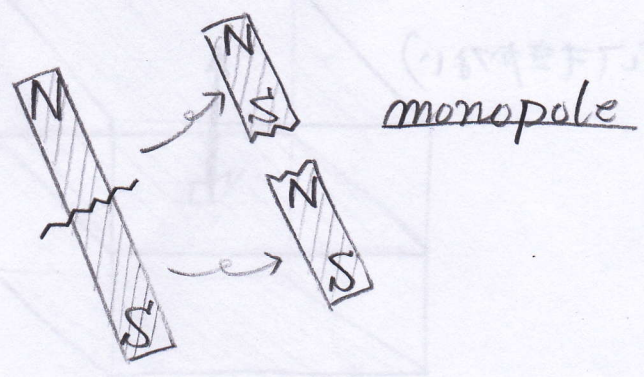
連続的分布

空間の各点 P での電荷密度が $\rho(P)$ であるとする。この場合、電場は
その点の近くでの
単位面積あたりの電荷の量。 $P = (P_1, P_2, P_3)$

$$E(x) = \int_{P \neq x} \frac{\rho(P)(x-P)}{4\pi\epsilon_0 \|x-P\|^3} dp_1 dp_2 dp_3$$

ビオ=サバールの法則 (Biot-Savart)

(電気 $+ \leftrightarrow -$)
(磁気 $N \leftrightarrow S$) } 全然ちがう!!



電流も磁場を生じる。

小柴 (トベル賞)

- 重力
- 電磁場
- 弱い相互作用
- 強い相互作用

四つの力 統一理論

陽子崩壊

宇宙物理学

電荷密度 $\rho(x)$ (スカラー関数)

速度 $v(x)$

$$\text{電流 } j(x) = \rho(x) \cdot v(x)$$

1点 P に微小の電流 δj が流れているとする。この電流によって引き起こされる

磁場 $\delta B(x)$ は、

$$\delta B(x) = \mu_0 \frac{\delta j \times (x - P)}{4\pi \|x - P\|^3} \quad (\text{ビオ・サバールの法則})$$

で与えられる。電流全体から生じる磁場は...

$$B(x) = \mu_0 \int_{\mathbb{R}^3} \frac{j(P) \times (x - P)}{4\pi \|x - P\|^3} dP_1 dP_2 dP_3$$

C を3次元空間内の閉曲線とする

$$m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

T : 周期

$$m(0) = m(T)$$

$$m(t+T) = m(t)$$

C の上をその向きの方に強さ I の電流が流れているとする。
(単位長さあたり I の電流)

$\{m(t) \mid t_0 < t < t_0 + \delta t\}$ 小部分

$$\left\| \frac{dm}{dt}(t_0) \right\| I \delta t$$

$m(t_0)$ での C の単位接ベクトル

小部分から生じる磁場 δB (ビオ・サバールの法則より)

$$\begin{aligned} (\delta B)(x) &= \mu_0 \frac{I \times (x - m(t_0))}{4\pi \|x - m(t_0)\|^3} \left\| \frac{dm}{dt}(t_0) \right\| I \delta t \\ &= \mu_0 \frac{\frac{dm}{dt}(t_0) \times (x - m(t_0))}{4\pi \|x - m(t_0)\|^3} I \delta t \end{aligned}$$

C上の電流全体が住んでいる磁場は、その総和

$$B(x) = -\frac{I\mu_0}{4\pi} \int_0^T \frac{(x - m(t)) \times \frac{dm}{dt}(t)}{\|x - m(t)\|^3} dt$$

で与えられる。

<例> $m(t) = (r \cos t, r \sin t, 0)$

$$x_0 = (x_1, x_2, x_3)$$

(「曜日まで」)

- I. $B(x)$ を書き下せ (積分計算はくじもよい)
- II. 原点 $(0, 0, 0)$ (積分も) $\rightarrow \left(a, a, \frac{I\mu_0}{2} \right)$

(702の法則 \rightarrow Gaussの法則)
 (ビオ・サヴァールの法則 \rightarrow アンペールの法則)

Cという閉曲線: 定常電流

Cは交わらない閉曲線L, 周期S

$$\vec{\ell}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\vec{\ell}(s+S) = \vec{\ell}(s)$$

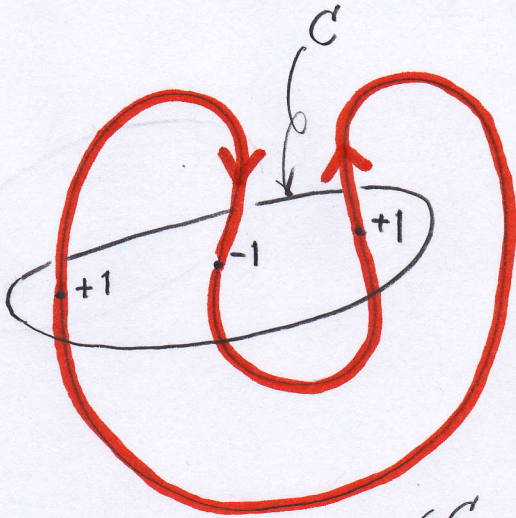
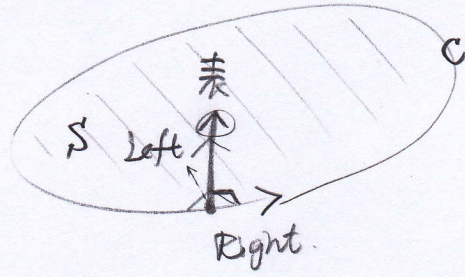
$$\int_L B \cdot d\vec{\ell} \text{ (線積分)}$$

$$= \frac{1}{4\pi} \int_0^S ds \int_0^T \frac{(\vec{\ell}(s) - \vec{m}(t)) \times \frac{dm}{dt}(t) \cdot \frac{d\vec{\ell}}{ds}(s)}{\|\vec{\ell}(s) - \vec{m}(t)\|^3} dt$$

$$= Lk(C, L)$$

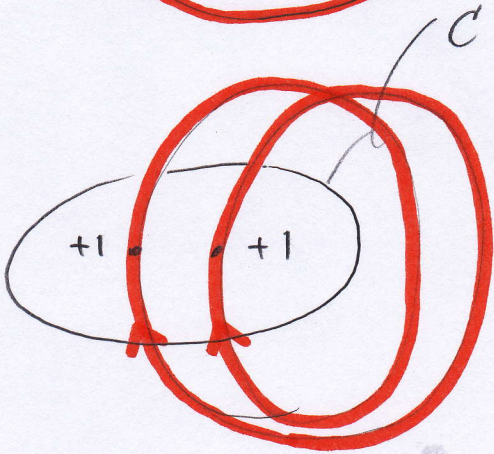
linking (絡み数)

Cを境界にもつ曲面Sを教える.

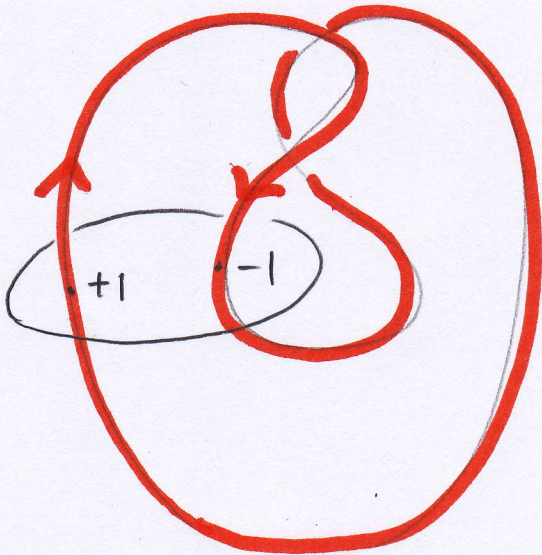


Sと3点(交点)

$$\begin{aligned} LK(C, L) &= (+1) + (-1) + (+1) \\ &= +1 \end{aligned}$$



$$LK(C, L) = +2$$



$$LK(C, L) = 0$$

静電気学
静電気学

クローンの法則

1点 P (位置ベクトル) に置かれた電荷 e を持つ点電荷は

$$E(x) = \frac{e(x-P)}{4\pi\epsilon_0 \|x-P\|^3}$$

空間の点 $P^{(1)}, \dots, P^{(N)}$ にそれぞれ電荷 e_1, \dots, e_N を持つ点電荷があるとする。この時これらが作る電場は

$$E(x) = \sum_{i=1}^N \frac{e_i(x-P^{(i)})}{4\pi\epsilon_0 \|x-P^{(i)}\|^3}$$

N はいくら大きくてもいい

$$P = (P_1, P_2)$$

空間の点 $P^{(1)}, \dots, P^{(N)}$ に

それぞれ電荷 e_1, \dots, e_N を持つ点電荷があるとする。この時これらが作る電場は

$$E(x) = \sum_{i=1}^N \frac{e_i(x-P^{(i)})}{4\pi\epsilon_0 \|x-P^{(i)}\|^3}$$

N はいくら大きくてもいい

$$P = (P_1, P_2, P_3)$$

連続的分布

空間の各点 P での電荷密度 $\rho(P)$ があるとする。

この場合には電場は

$$E(x) = \int \frac{\rho(P)(x-P)}{4\pi\epsilon_0 \|x-P\|^3}$$

この式の分母は単位体積電荷の量

連続的分布

連続分布の空間の各点 P での電荷密度 $\rho(P)$ があるとする

この場合には電場は

$$E(\mathbf{r}) = \int_{P \neq \mathbf{r}} \frac{\rho(P)(\mathbf{r}-P)}{4\pi\epsilon_0 \|\mathbf{r}-P\|^3} dP_1 dP_2 dP_3$$

この点の近くでの単位体積あたりの電荷の量 ρ

連続分布の場合の場は P_i

$\rho(P_i) \parallel \int_{(P_1, P_2, P_3)}$

ビオ=サヴァン法則 (Biot) (Savart)

宇宙線物

小柴重力実験

電磁場

弱相互作用

強相互作用

統一理論

陽子

電流

磁場

monopole 力の

$$\int B(\mathbf{r}) = \mu_0 \int \frac{J(\mathbf{r})(\mathbf{r}-P)}{4\pi \|\mathbf{r}-P\|^3}$$

$\frac{1}{r^2} \sin \theta$

宇宙物理学
銀河 新星

電荷密度 $\rho(x)$ (スカラー関数)
 $v(x)$ 速度

統一理論
↓
陽子加速器

$$\rho(x)v(x) = j(x)$$

電流

1点Pに微小な電流 j が流れているとする。この電流によって起こされる磁場 $B(x)$ は

$$\mu \frac{j(x)(x-P)}{4\pi \|x-P\|^3}$$

物理学
新星

電荷密度 $\rho(x)$ (スカラー関数)
 $v(x)$ 速度

統一理論

$$\rho(x)v(x) = j(x)$$

電流

陽子加速器

1点Pに微小な電流 j が流れているとする。この電流によって引き起こされる磁場 $B(x)$ は

$$\mu \frac{j(x)(x-P)}{4\pi \|x-P\|^3}$$

電流全体が生じる磁場は

$$B(x) = \mu_0 \int_{\mathbb{R}^3} \frac{j(P) \times (x - P)}{4\pi \|x - P\|^3} dP_1 dP_2 dP_3$$

C を \mathbb{R}^3 空間内の閉曲線

$$\vec{m}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad \vec{m}(0) = \vec{m}(T)$$

T 周期

$$\vec{m}(t+T) = \vec{m}(t)$$

$$\int_{\mathbb{R}^3} dP_1 dP_2 dP_3$$

C の上を \vec{m} の向きに
強さ I の電流が流れている

(単位長さあたり I の電流)

$\vec{m}(T)$

$$\left\{ \vec{m}(t) \mid t_0 \leq t < t_0 + \delta t \right\}$$

$$\left\| \frac{d\vec{m}}{dt}(t_0) \right\| I \delta t$$

その向きと同じに
Iの電流が流れているとする

(単位長さあたりIの電流)

(t) | $t_0 < t < t_0 + \delta t$ } 小さな部分

$$\frac{d\vec{m}}{dt}(t_0) \parallel I \delta t$$

小部分から生じる磁場は $\vec{m}(t_0)$ の

$$(\delta B)(\vec{r}) = \mu_0 \frac{\vec{e} \times (\vec{r} - \vec{m}(t_0))}{4\pi \|\vec{r} - \vec{m}(t_0)\|^3} \parallel \frac{d\vec{m}}{dt}$$

$$= \mu_0 \frac{\frac{d\vec{m}}{dt}(t_0) \times (\vec{r} - \vec{m}(t_0))}{4\pi \|\vec{r} - \vec{m}(t_0)\|^3} I \delta t$$

B

のCの単位接点ル

$$\frac{1}{3} \left\| \frac{d\vec{m}}{dt}(t_0) \right\| I \delta t$$

$I \delta t$

C上の電流全体が
生ずる磁場の総和として

$$B(\mathbf{x}) = -\frac{I\mu_0}{4\pi} \int_0^T \frac{(\mathbf{x} - \vec{m}(t))}{\|\mathbf{x} - \vec{m}(t)\|^3}$$

ル

$I \delta t$

C上の電流全体が生ずる磁場は
の総和として

$$\frac{I\mu_0}{4\pi} \int_0^T \frac{(\mathbf{x} - \vec{m}(t)) \times \frac{d\vec{m}}{dt}(t)}{\|\mathbf{x} - \vec{m}(t)\|^3} dt$$

例

$$\vec{m}(t) = (r \cos t, r \sin t, 0)$$

$$x = (x_1, x_2, x_3)$$

I $B(x)$ を書き下せ
積分は残して...

II 原点 $(0, 0, 0)$
 $(0, 0, \frac{I \mu_0}{2r})$

C は閉曲線
逆方向

C は交点

$$\vec{l}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\vec{l}(s+S) = \vec{l}(s)$$

$(t, 0)$ C は閉曲線
逆方向

$\nabla \cdot \vec{J} = 0$ の場合 \Rightarrow Gauss

$\nabla \cdot \vec{J} = 4\pi \rho$ の場合 \Rightarrow

C は交点のない閉曲線 L 周期 S

$$\vec{l}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\vec{l}(s+S) = \vec{l}(s)$$

$$\int_L B \cdot d\vec{l}$$

7-コングレム ⇒ Gaussの法則
 ヒト=サハ-ル9法則 ⇒ 7,ハ-ル9法則

曲線 $\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ (線積分)
 面 S

C, \subset

$$\frac{1}{4\pi} \int_0^S ds \int_0^T \frac{(\vec{l}(s) - \vec{m}(t)) \times \frac{d\vec{m}}{dt}(t)}{\|\vec{l}(s) - \vec{m}(t)\|^3}$$
 C の境界を持つ 曲面 S を考える
 向き

